

Elektronika

Auditorne vježbe 3

- Silicijskom poluvodiču dodane su akceptorske primjese gustoće N_A=10¹⁴ cm⁻³. Odrediti gustoće slobodnih nosilaca naboja na temperaturama:
 - a) 0°C
 - b) 27°C
 - c) 175°C

Rješenje:

a) *T*=273,15 K:

$$E_G$$
=1,1312 eV

$$n_i = 7,72 \cdot 10^8 \text{ cm}^{-3}$$

(1)
$$n_0 + N_A = p_0$$

(2) $n_0 \cdot p_0 = n_i^2$

$$(2) \quad n_0 \cdot p_0 = n_i^2$$

$$N_A^2 >> n_i^2 \implies p_0 \approx N_A$$

$$p_0 = \frac{N_A + \sqrt{N_A^2 + 4n_i^2}}{2}$$

$$p_0 \approx 10^{14} \, cm^{-3}$$

$$n_0 = \frac{n_i^2}{p_0} = 5954 \ cm^{-3}$$

☑ Rješenje:

$$E_G$$
=1,1245 eV

$$n_i = 8,68 \cdot 10^9 \text{ cm}^{-3}$$

$$N_A^2 >> n_i^2 \Rightarrow p_0 \approx N_A$$

$$p_0 \approx 10^{14} \, cm^{-3}$$

$$n_0 = \frac{n_i^2}{p_0} = 7,53 \cdot 10^5 \ cm^{-3}$$

✓ Rješenje:

c) *T*=448 K:

$$E_G$$
=1,0824 eV

$$n_i = 3.63 \cdot 10^{13} \text{ cm}^{-3}$$

$$p_0 = \frac{N_A + \sqrt{N_A^2 + 4n_i^2}}{2} = 1,12 \cdot 10^{14} \, cm^{-3}$$

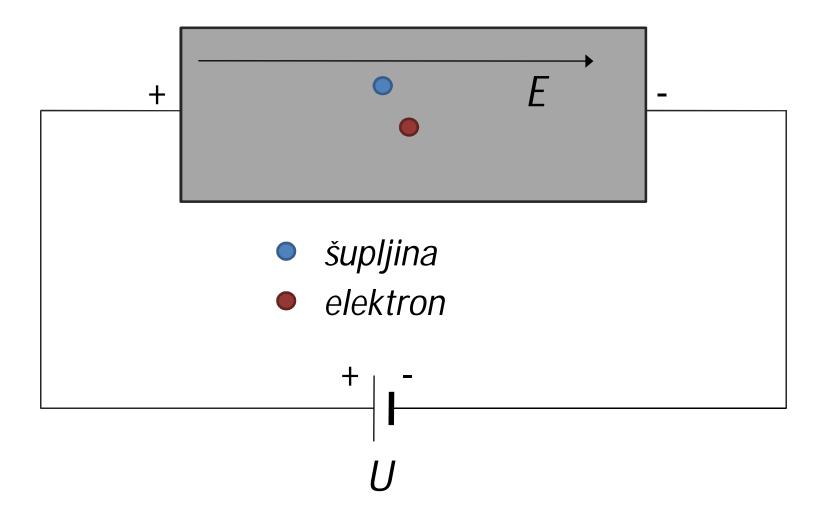
$$n_0 = \frac{n_i^2}{p_0} = 1,18 \cdot 10^{13} \ cm^{-3}$$

Gibanje nosilaca u poluvodiču

- Usmjereno gibanje nosilaca električna struja.
- Smjer struje:
 - Jednak smjeru gibanja pozitivnih naboja (šupljina).
 - Suprotan smjeru gibanja negativnih naboja (elektrona).
- Dva osnovna mehanizma:
 - Električno polje DRIFT
 - Nejednolika raspodjela nosilaca DIFUZIJA

Driftno gibanje

Gibanje nosilaca pod utjecajem električnog polja.



Driftno gibanje

- O čemu ovisi driftno gibanje?
- Iznos i smjer priključenog električnog polja!
- Sposobnost gibanja elektrona i šupljine u poluvodiču POKRETLJIVOST!
- Pokretljivost: μ [cm²/Vs]
 - elektrona μ_n
 - šupljina μ_p
- Pokretljivost ovisi o:
 - gustoći primjesa
 - temperaturi
 - jakosti električnog polja
 - raspršenju i međusobnim sudarima nosilaca i dr.



Pokretljivost nosilaca

• U siliciju na *T*=300 K:

$$\mu = \mu_{\min} + \frac{\mu_{maks} - \mu_{\min}}{1 + \left(\frac{N}{N_{ref}}\right)^{\alpha}}$$

nosilac	N _{ref} [cm ⁻³]	µ _{maks} [cm ² V ⁻¹ s ⁻¹]	μ _{min} [cm ² V ⁻¹ s ⁻¹]	α
elektron	1,12·10 ¹⁷	1430	80	0,72
šupljina	2,23·10 ¹⁷	460	45	0,72

Električna provodnost

- Električna provodnost: σ [S/cm]
- Ukupna provodnost poluvodiča je zbroj provodnosti zbog gibanja elektrona i šupljina:

$$\sigma = \sigma_n + \sigma_p$$

$$\sigma_n = q \cdot n \cdot \mu_n \qquad \sigma_p = q \cdot p \cdot \mu_p$$

Zadatak 5.

 Izračunati električnu provodnost silicija pri temperaturi T=300 K, ako je gustoća primjesa: N_A=10¹⁴ cm⁻³.

a)
$$N_D = N_A = 0$$

b)
$$N_D = 10^{16} \text{ cm}^{-3}, N_A = 0$$

c)
$$N_A = 10^{16} \text{ cm}^{-3}, N_D = 0$$

d)
$$N_D = N_A = 10^{16} \text{ cm}^{-3}$$

Driftna struja

- Gustoća struje: J [A/cm²]
- Driftno gibanje elektrona:

$$J_{n \, drift} = q \cdot \mu_n \cdot n \cdot E$$

Driftno gibanje šupljina:

$$J_{p \, drift} = q \cdot \mu_p \cdot p \cdot E$$

Difuzijsko gibanje

- Nejednolika raspodjela nosilaca u volumenu poluvodiča.
- Gibanje nosilaca: iz područja veće u područje manje gustoće.
- Difuzijsko gibanje traje dok se gustoća ne izjednači u cijelom volumenu.
- Difuzijska konstanta: D [cm²/s]
 - elektrona D_n
 - šupljina D_p



Difuzijska struja

- Gustoća struje: J [A/cm²]
- Difuzijsko gibanje elektrona:

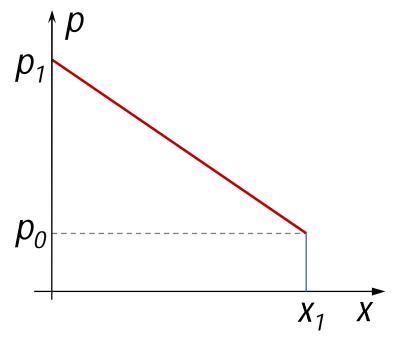
$$J_n = +q \cdot D_n \cdot \frac{dn}{dx}$$

Difuzijsko gibanje šupljina:

$$J_p = -q \cdot D_p \cdot \frac{dp}{dx}$$

Zadatak 6.

Djelovanjem svjetla generiraju se dodatni (*ekscesni*)
nosioci uz površinu silicija. Odediti sve komponente
struja (difuzijske i driftne) većinskih i manjinskih
nosilaca,ako je raspodjela šupljina dana prema
prikazanom crtežu:



Poznato je još:

$$T = 300 \text{ K}$$

$$x_1 = 10 \, \mu \text{m}$$

$$p_0 = 10^4 \text{ cm}^{-3}$$

a)
$$p_1 = 10^8$$
 cm⁻³

b)
$$p_2 = 10^{16} \text{ cm}^{-3}$$